TLx84xB 高性能電流モード PWM コントローラ

1 特長

- 低いスタートアップ電流 (0.5mA 未満)
- トリムされた発振器放電電流
- 最大 500kHz の電流モード動作
- 自動フィードフォワード補償
- ラッチ PWM によるサイクルごとの電流制限
- 内部トリムされたリファレンス電圧、低電圧誤動作防止付き
- ヒステリシス付きの大電流トーテムポール出力低電圧誤動作防止
- ダブル パルス抑制

2 アプリケーション

- あらゆる極性のスイッチング レギュレータ
- トランス結合型 DC/DC コンバータ

3 概要

TL284xB および TL384xB シリーズの制御 IC には、オフラインまたは DC-DC 固定周波数の電流モード制御方式を最小限の外付け部品で実装するために必要な機能が搭載されています。低電圧誤動作防止 (UVLO) および高精度リファレンス電圧を内蔵し、エラー アンプ入力における精度を向上するようトリムされています。それ以外にも、ラッチ動作を保証するロジック、パルス幅変調 (PWM) コンパレータ (電流制限制御の機能も兼ねています)、大きなピーク電流をソースまたはシンクするように設計されたトーテムポール出力段が内蔵されています。出力段は N チャネル MOSFET の駆動に適しており、オフ状態では Low になります。

TL284xB および TL384xB シリーズは、標準の TL284x および TL384x とピン互換であり、以下の点が改善されています。スタートアップ電流は 0.5mA (最大値) に規定され、発振器放電電流は 8.3mA (標準値) にトリムされています。また、低電圧誤動作防止状態では、10mA をシンクしているときの出力の飽和電圧は 1.2V です (V_{CC} = 5V)。

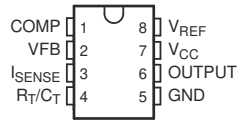
これらのシリーズに属する製品間の主な違いは、UVLO スレッショルドおよび最大デューティ サイクル範囲です。UVLO スレッショルドの標準値は、TLx842B および TLx844B デバイスでは 16V (オン) と 10V (オフ) であり、オフラインのアプリケーションに理想的です。TLx843B および TLx845B デバイスについては、対応するスレッショルドの標準値は、8.4V (オン) と 7.6V (オフ) です。TLx842B および TLx843B デバイスは、100% に近いデューティ サイクルで動作可能です。TLx844B および TLx845B には、内部にトグル フリップ フロップが追加されているため、デューティ サイクルの範囲は 0%～50% となります。この結果、2 クロック サイクルごとに出力がオフになります。TL284xB シリーズのデバイスは -40℃～85℃、TL384xB シリーズのデバイスは 0℃～70℃での動作が規定されています。

パッケージ情報

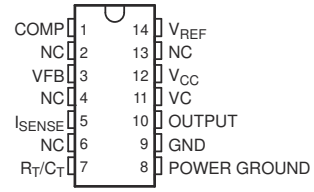
部品番号	パッケージ(1)	パッケージ サイズ(2)
TLx84x	D (SOIC、8)	4.90mm × 6.00mm
	D (SOIC、14)	8.65mm × 6.00mm
	P (PDIP、8)	9.81mm × 9.43mm

(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
(2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。

D (SOIC) OR P (PDIP) PACKAGE
(TOP VIEW)



D (SOIC) PACKAGE
(TOP VIEW)

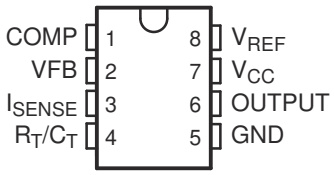


NC – No internal connection

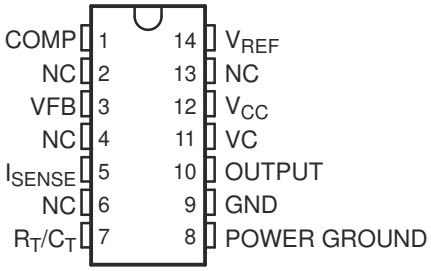
Table of Contents

4 Pin Configuration and Functions

D (SOIC) OR P (PDIP) PACKAGE
(TOP VIEW)



D (SOIC) PACKAGE
(TOP VIEW)



NC – No internal connection

PIN			Type[1]	DESCRIPTION
NAME	D (14 pins)	D or P (8 pins)		
COMP	1	1	I/O	Error amplifier compensation pin
GND	9	5	-	Device power supply ground terminal
ISENSE	5	3	I	Current sense comparator input
NC	2, 4, 6, 13	-	-	Do not connect
OUTPUT	10	6	O	PWM Output
POWER GROUND	8	-	-	Output PWM ground terminal
REF	14	8	O	Oscillator voltage reference
RT/CT	7	4	I/O	Oscillator RC input
VC	11	-	-	Output PWM positive voltage supply
VCC	12	7	-	Device positive voltage supply
VFB	3	2	I	Error amplifier input

(1) I = Input; O = Output; I/O = Input or Output

5 Specifications

5.1 Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted) (1) (2)

			MIN	MAX	UNIT
V_{CC}	Supply voltage	Low impedance source		30	V
		I_{CC} < 30 mA		Self limiting	
V_I	Analog input voltage range	VFB and I_{SENSE}	–0.3	6.3	V
I_{CC}	Supply current			30	mA
I_O	Output current			±1	A
$I_{O(sink)}$	Error amplifier output sink current			10	mA
	Output energy	Capacitive load		5	µJ
T_J	Virtual junction temperature			150	°C
T_{stg}	Storage temperature range		–65	150	°C

(1) Operation outside the *Absolute Maximum Ratings* may cause permanent device damage. *Absolute Maximum Ratings* do not imply functional operation of the device at these or any other conditions beyond those listed under *Recommended Operating Conditions*. If used outside the *Recommended Operating Conditions* but within the *Absolute Maximum Ratings*, the device may not be fully functional, and this may affect device reliability, functionality, performance, and shorten the device lifetime.
(2) All voltages are with respect to the device GND terminal.

5.2 ESD Ratings

			VALUE	UNIT
$V_{(ESD)}$	Electrostatic discharge	Human body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001, all pins(1)	±3000	V
		Charged device model (CDM), per JEDEC specification JESD22-C101, all pins(2)	±2000	

(1) JEDEC document JEP155 states that 500-V HBM allows safe manufacturing with a standard ESD control process.
(2) JEDEC document JEP157 states that 250-V CDM allows safe manufacturing with a standard ESD control process.

5.3 Recommended Operating Conditions

			MIN	NOM	MAX	UNIT
V_{CC}	Supply voltage	V_{CC}			30	V
		VC(1)			30	
V_I	Input voltage	R_T/C_T	0		5.5	V
		VFB and I_{SENSE}	0		5.5	
V_O	Output voltage	OUTPUT	0		30	V
		POWER GROUND(1)	–0.1		1	
I_{CC}	Supply current, externally limited				25	mA
I_O	Average output current				200	mA
$I_{O(ref)}$	Reference output current				–20	mA
f_{osc}	Oscillator frequency			100	500	kHz
T_J	Operating free-air temperature	TL284xB	–40		85	°C
		TL384xB	0		70	

(1) The recommended voltages for VC and POWER GROUND apply only to the 14-pin D package.

5.4 Thermal Information

THERMAL METRIC[1]		TLx84xB			UNIT
		D	P	D	
		8 PINS	8 PINS	14 PINS	
$R_{\theta JA}$	Junction-to-ambient thermal resistance	117.4	74.1	87.9	°C/W

(1) For more information about traditional and new thermal metrics, see the *Semiconductor and IC Package Thermal Metrics* application note.

5.5 Reference Section Electrical Characteristics

V_{CC} = 15 V[1], R_T = 10 kΩ, C_T = 3.3 nF, over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise specified)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	TL284xB			TL384xB			UNIT
		MIN	TYP[2]	MAX	MIN	TYP[2]	MAX	
Output voltage	I_O = 1 mA, T_J = 25°C	4.95	5	5.05	4.9	5	5.1	V
Line regulation	V_{CC} = 12 V to 25 V		6	20		6	20	mV
Load regulation	I_O = 1 mA to 20 mA		6	25		6	25	mV
Average temperature coefficient of output voltage			0.2	0.4		0.2	0.4	mV/°C
Output voltage, worst-case variation	V_{CC} = 12 V to 25 V, I_O = 1 mA to 20 mA	4.9		5.1	4.82		5.18	V
Output noise voltage	f = 10 Hz to 10 kHz, T_J = 25°C		50			50		μV
Output-voltage long-term drift	After 1000 h at T_J = 25°C		5	25		5	25	mV
Short-circuit output current		–30	–100	–180	–30	–100	–180	mA

(1) Adjust V_{CC} above the start threshold before setting V_{CC} to 15 V.
(2) All typical values are at T_J = 25°C.

5.6 Oscillator Section Electrical Characteristics

V_{CC} = 15 V[1], R_T = 10 kΩ, C_T = 3.3 nF, over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise specified) [3]

PARAMETER	TEST CONDITIONS	TL284xB			TL384xB			UNIT
		MIN	TYP[2]	MAX	MIN	TYP[2]	MAX	
Initial accuracy	T_J = 25°C	47	52	57	47	52	57	kHz
	T_A = T_{low} to T_{high}	44		60	44		60	
	T_J = 25°C, R_T = 6.2 kΩ, C_T = 1 nF	225	250	275	225	250	275	
Voltage stability	V_{CC} = 12 V to 25 V		0.2	1		0.2	1	%
Temperature stability			5			5		%
Amplitude	Peak to peak		1.7			1.7		V
Discharge current	T_J = 25°C, R_T/C_T = 2 V	7.8	8.3	8.8	7.8	8.3	8.8	mA
	R_T/C_T = 2 V	7.5		8.8	7.6		8.8	

(1) Adjust V_{CC} above the start threshold before setting it to 15 V.
(2) All typical values are at T_J = 25°C.
(3) Output frequency equals oscillator frequency for the TL3842B and TL3843B. Output frequency is one-half the oscillator frequency for the TL3844B and TL3845B.

5.7 Error-Amplifier Section Electrical Characteristics

V_{CC} = 15 V[1], R_T = 10 kΩ, C_T = 3.3 nF, over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise specified)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	TL284xB			TL384xB			UNIT
		MIN	TYP[2]	MAX	MIN	TYP[2]	MAX	
Feedback input voltage	COMP = 2.5 V	2.45	2.5	2.55	2.42	2.5	2.58	V
Input bias current			–0.3	–1		–0.3	–2	μA
Open-loop voltage amplification	V_O = 2 V to 4 V	65	90		65	90		dB
Gain-bandwidth product		0.7	1		0.7	1		MHz
Supply-voltage rejection ratio	V_{CC} = 12 V to 25 V	60	70		60	70		dB
Output sink current	VFB = 2.7 V, COMP = 1.1 V	2	6		2	6		mA
Output source current	VFB = 2.3 V, COMP = 5 V	–0.5	–0.8		–0.5	–0.8		mA
High-level output voltage	VFB = 2.3 V, R_L = 15 kΩ to GND	5	6		5	6		V
Low-level output voltage	VFB = 2.7 V, R_L = 15 kΩ to GND		0.7	1.1		0.7	1.1	V

(1) Adjust V_{CC} above the start threshold before setting it to 15 V.
(2) All typical values are at T_J = 25°C.

5.8 Current-Sense Section Electrical Characteristics

V_{CC} = 15 V[4], R_T = 10 kΩ, C_T = 3.3 nF, over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise specified)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	TL284xB			TL384xB			UNIT
		MIN	TYP[1]	MAX	MIN	TYP[1]	MAX	
Voltage amplification[2] [3]		2.85	3	3.15	2.85	3	3.15	V/V
Current-sense comparator threshold[2]	COMP = 5 V	0.9	1	1.1	0.9	1	1.1	V
Supply-voltage rejection ratio[2]	V_{CC} = 12 V to 25 V		70			70		dB
Input bias current			–2	–10		–2	–10	μA
Delay time to output	VFB = 0 V to 2 V		150	300		150	300	ns

(1) All typical values are at T_J = 25°C.
(2) Measured at the trip point of the latch, with VFB at 0 V.
(3) Measured between I_{SENSE} and COMP, with the input changing from 0 V to 0.8 V.
(4) Adjust V_{CC} above the start threshold before setting V_{CC} to 15 V.

5.9 Output Section Electrical Characteristics

V_{CC} = 15 V[2], R_T = 10 kΩ, C_T = 3.3 nF, over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise specified)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	TL284xB			TL384xB			UNIT
		MIN	TYP[1]	MAX	MIN	TYP[1]	MAX	
High-level output voltage	I_{OH} = –20 mA	13	13.5		13	13.5		V
	I_{OH} = –200 mA	12	13.5		12	13.5		
Low-level output voltage	I_{OL} = 20 mA		0.1	0.4		0.1	0.4	V
	I_{OL} = 200 mA		1.5	2.2		1.5	2.2	
Rise time	C_L = 1 nF, T_J = 25°C		25	150		25	150	ns
Fall time	C_L = 1 nF, T_J = 25°C		25	150		25	150	ns
UVLO saturation	V_{CC} = 5 V, I_{OL} = 1 mA		0.7	1.2		0.7	1.2	V

(1) All typical values are at T_J = 25°C.
(2) Adjust V_{CC} above the start threshold before setting V_{CC} to 15 V.

5.10 Undervoltage-Lockout Section Electrical Characteristics

V_{CC} = 15 V[2], R_T = 10 kΩ, C_T = 3.3 nF, over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise specified)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	TL284xB			TL384xB			UNIT
		MIN	TYP[1]	MAX	MIN	TYP[1]	MAX	
Start threshold voltage	TLx842B, TLx844B	15	16	17	14.5	16	17.5	V
	TLx843B, TLx845B	7.8	8.4	9	7.8	8.4	9	
Minimum operating voltage after start-up	TLx842B, TLx844B	9	10	11	8.5	10	11.5	V
	TLx843B, TLx845B	7	7.6	8.2	7	7.6	8.2	

(1) All typical values are at T_J = 25°C.
(2) Adjust V_{CC} above the start threshold before setting V_{CC} to 15 V.

5.11 Pulse-Width Modulator Section Electrical Characteristics

V_{CC} = 15 V[2], R_T = 10 kΩ, C_T = 3.3 nF, over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise specified)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	TL284xB			TL384xB			UNIT
		MIN	TYP[1]	MAX	MIN	TYP[1]	MAX	
Maximum duty cycle	TLx842B, TLx843B	92	96	100	92	96	100	%
	TLx844B, TLx845B	46	48	50	46	48	50	
Minimum duty cycle				0			0	%

(1) All typical values are at T_J = 25°C.
(2) Adjust V_{CC} above the start threshold before setting it to 15 V.

5.12 Supply Voltage Electrical Characteristics

V_{CC} = 15 V[2], R_T = 10 kΩ, C_T = 3.3 nF, over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise specified)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	TL284xB			TL384xB			UNIT
		MIN	TYP[1]	MAX	MIN	TYP[1]	MAX	
Start-up current			0.3	0.5		0.3	0.5	mA
Operating supply current	VFB and I_{SENSE} at 0 V		11	17		11	17	mA
Limiting voltage	I_{CC} = 25 mA	30	39		30	39		V

(1) All typical values are at T_J = 25°C.
(2) Adjust V_{CC} above the start threshold before setting it to 15 V.

5.13 Typical Characteristics

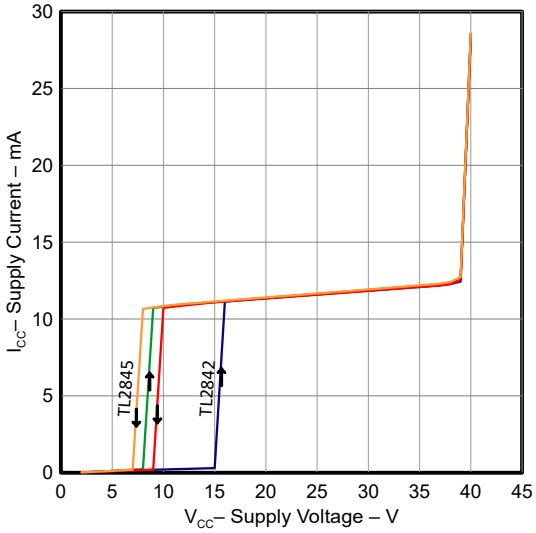


図 5-1. Supply Current vs Supply Voltage

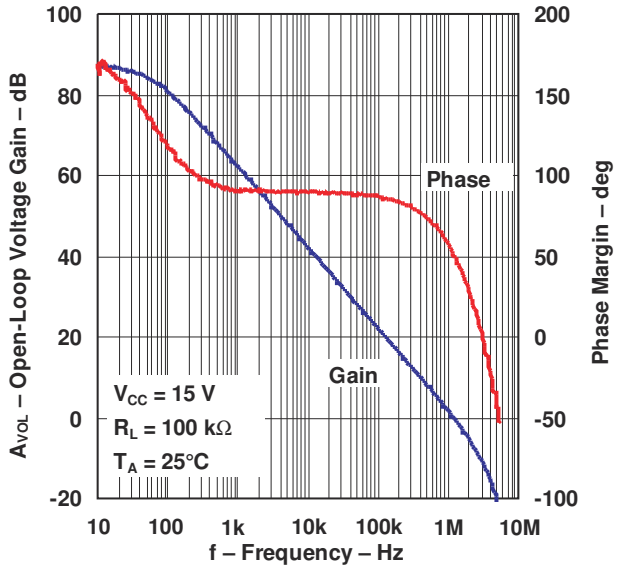


図 5-2. Error Amplifier Open-Loop Gain And Phase vs Frequency

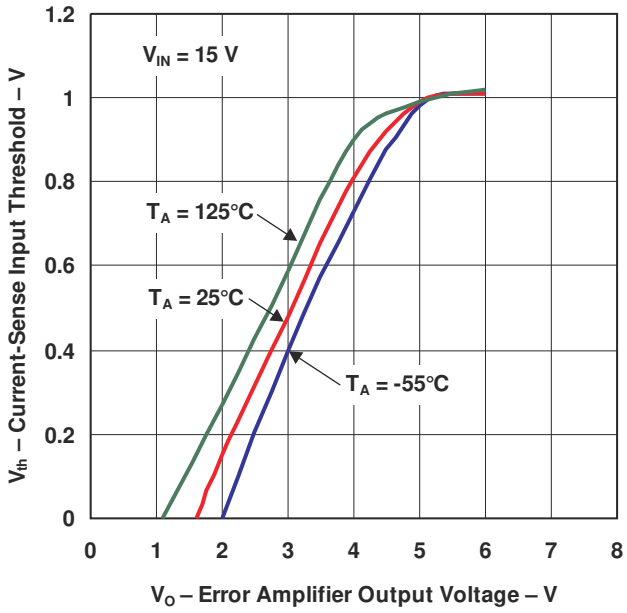


図 5-3. Current-Sense Input Threshold vs Error Amplifier Output Voltage

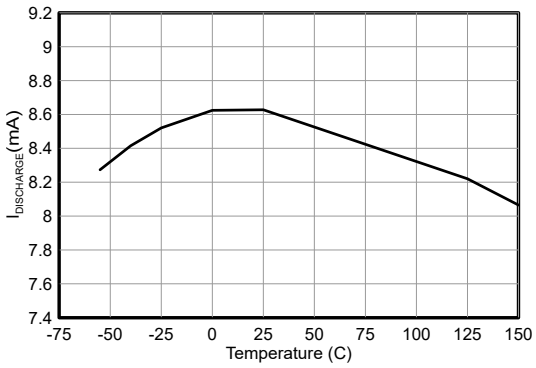


図 5-4. Oscillator Discharge Current vs Temperature

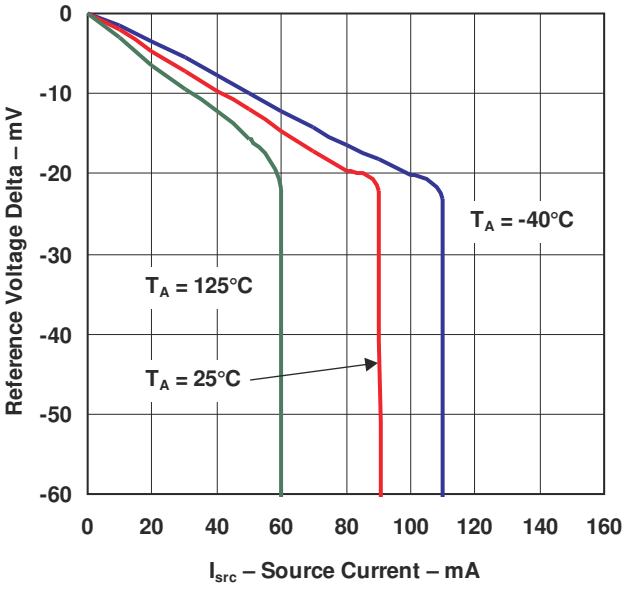


図 5-5. Reference Voltage vs Source Current

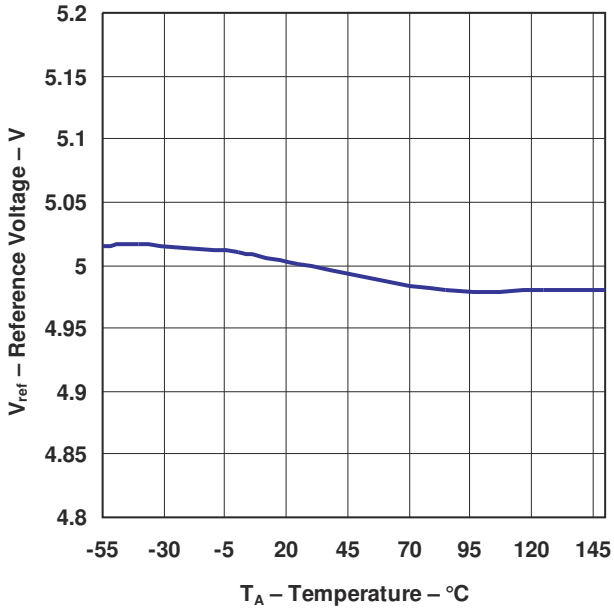


図 5-6. Reference Voltage vs Temperature

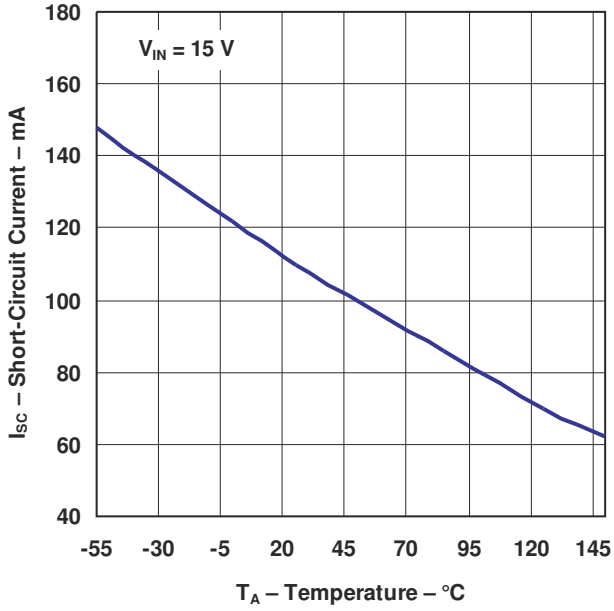


図 5-7. Reference Short-Circuit Current vs Temperature

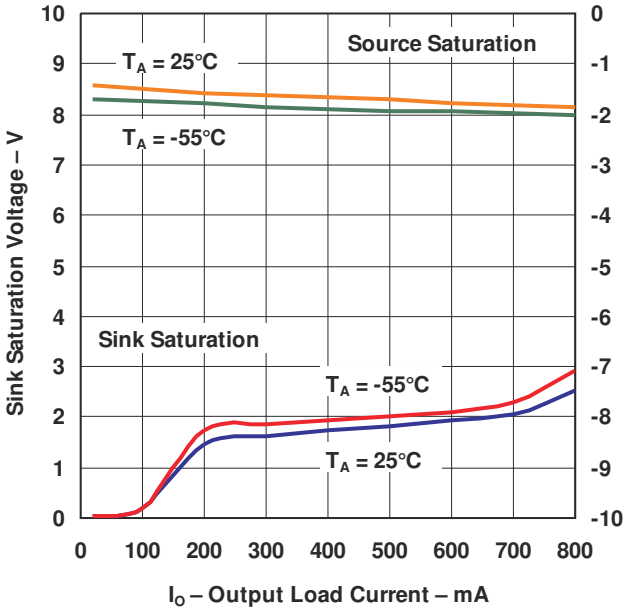


図 5-8. Output Saturation Voltage vs Load Current

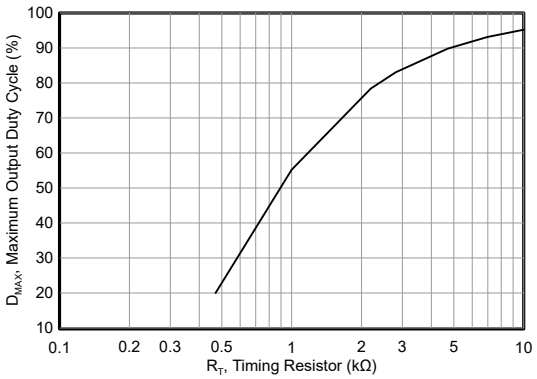
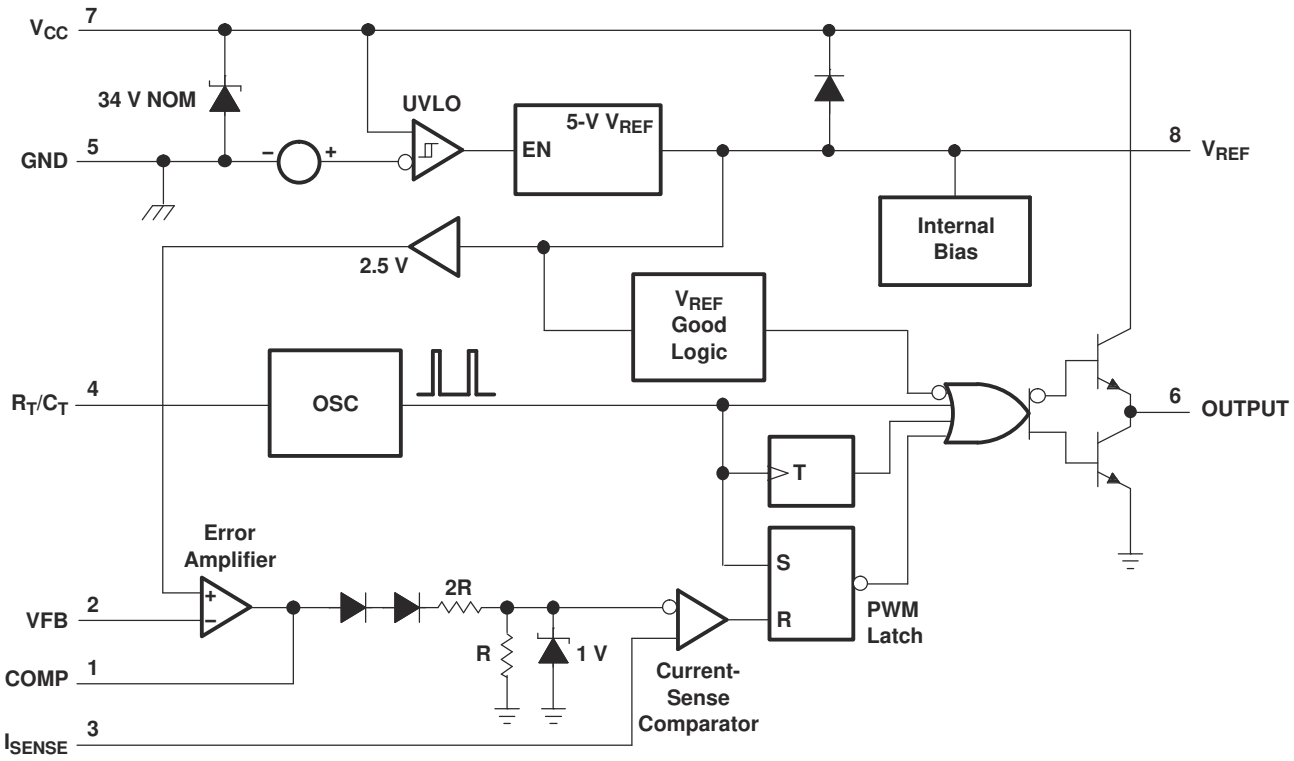


図 5-9. Maximum Output Duty Cycle vs Timing Resistor

6 Detailed Description

6.1 Functional Block Diagram



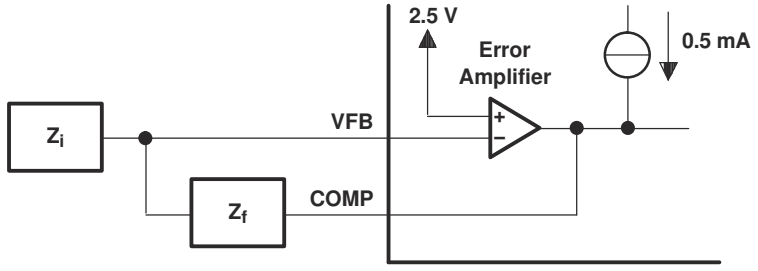
7 Application and Implementation

注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

7.1 Application Information

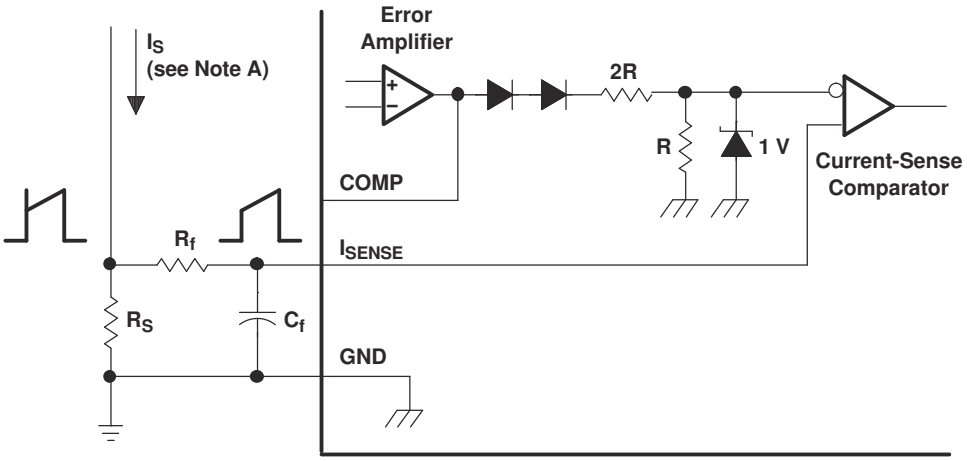
The error-amplifier configuration circuit is shown in 図 7-1.



A. Error amplifier can source or sink up to 0.5 mA.

図 7-1. Error-Amplifier Configuration

The current-sense circuit is shown in 図 7-2.



A. Peak current (I_S) is determined by the formula: $I_{S(max)}$ = 1 V/R_S

B. A small RC filter formed by resistor R_f and capacitor C_f may be required to suppress switch transients.

図 7-2. Current-Sense Circuit

The oscillator frequency is set using the circuit shown in 図 7-3. The frequency is calculated as:

$f = 1 / R_T C_T$

For $R_T > 5$ kΩ:

$f \approx 1.72 / R_T C_T$

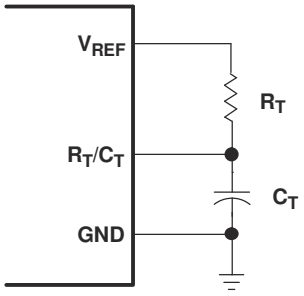


図 7-3. Oscillator Section

7.2 Shutdown Technique

The PWM controller (see 図 7-4) can be shut down by two methods: either raise the voltage at I_{SENSE} above 1 V or pull the COMP terminal below a voltage two diode drops above ground. Either method causes the output of the PWM comparator to be high (refer to block diagram). The PWM latch is reset dominant so that the output remains low until the next clock cycle after the shutdown condition at the COMP or I_{SENSE} terminal is removed. In one example, an externally latched shutdown can be accomplished by adding an SCR that resets by cycling V_{CC} below the lower UVLO threshold. At this point, the reference turns off, allowing the SCR to reset.

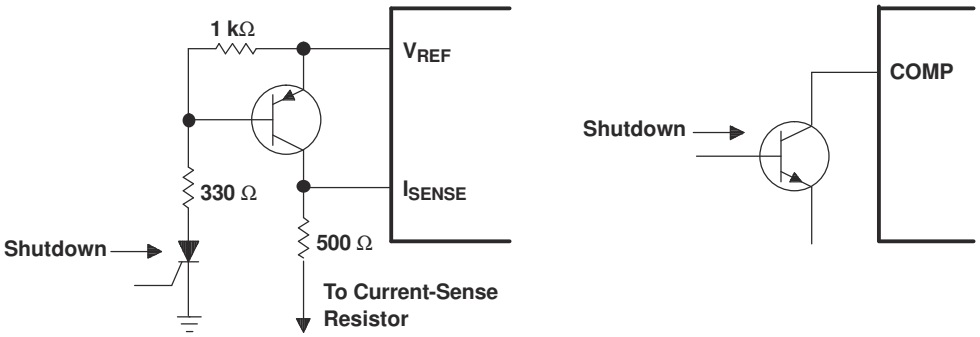


図 7-4. Shutdown Techniques

A fraction of the oscillator ramp can be summed resistively with the current-sense signal to provide slope compensation for converters requiring duty cycles over 50% (see 図 7-5). Note that capacitor C forms a filter with R2 to suppress the leading-edge switch spikes.

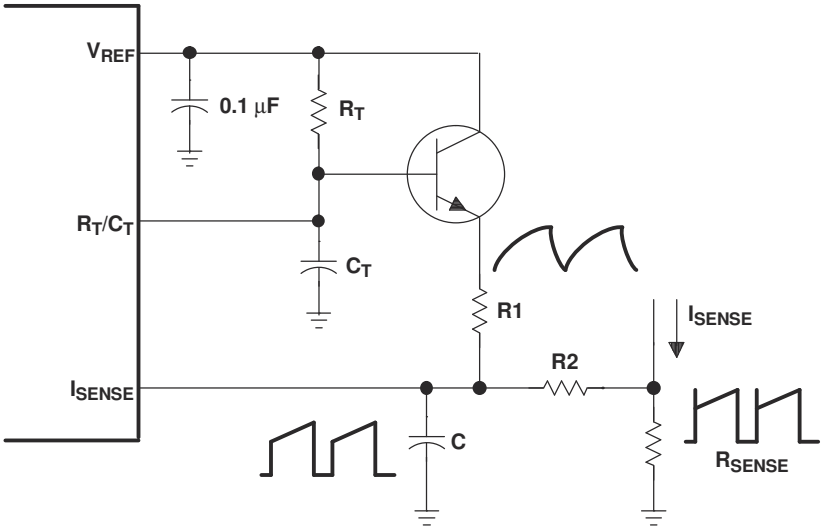


図 7-5. Slope Compensation

7.3 Open-Loop Laboratory Test Fixture

In the open-loop laboratory test fixture (see 図 7-6), high peak currents associated with loads necessitate careful grounding techniques. Timing and bypass capacitors should be connected close to the GND terminal in a single-point ground. The transistor and 5-kΩ potentiometer sample the oscillator waveform and apply an adjustable ramp to the I_{SENSE} terminal.

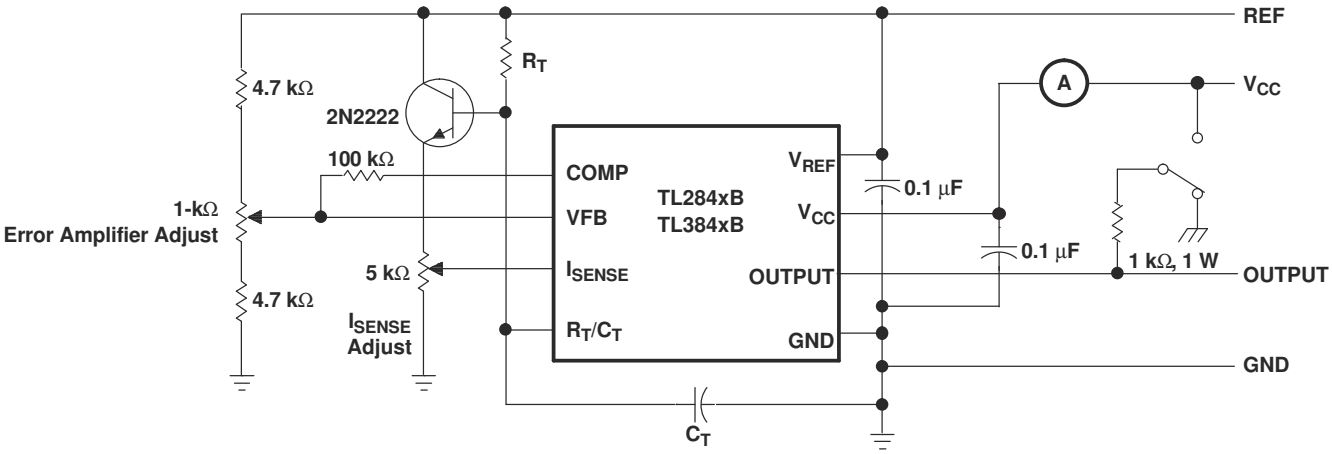
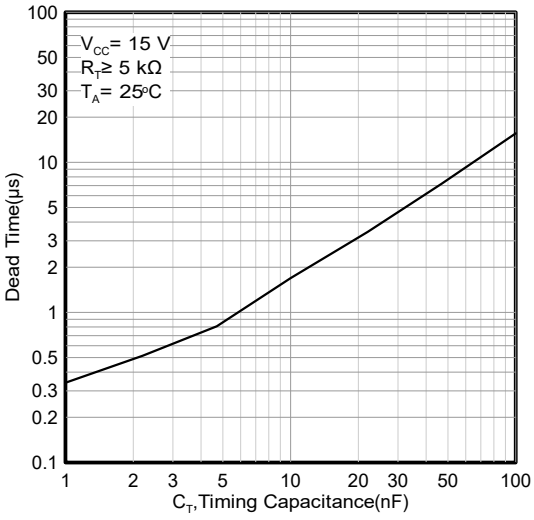
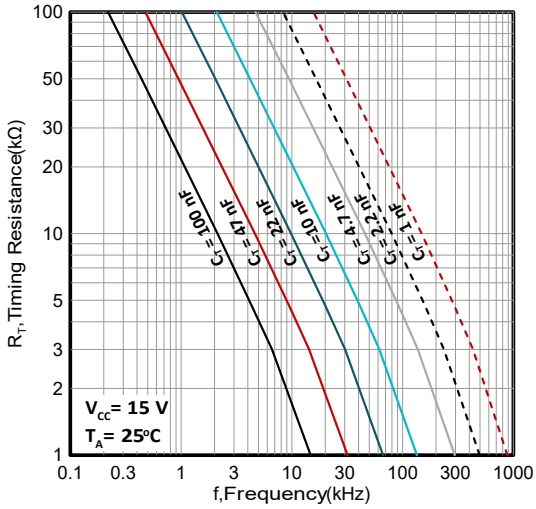


図 7-6. Open-Loop Laboratory Test Fixture

7.4 Typical Application

7.4.1 Application Curves





8 Device and Documentation Support

8.1 Related Links

The table below lists quick access links. Categories include technical documents, support and community resources, tools and software, and quick access to sample or buy.

表 8-1. Related Links

PARTS	PRODUCT FOLDER	SAMPLE & BUY	TECHNICAL DOCUMENTS	TOOLS & SOFTWARE	SUPPORT & COMMUNITY
TL284xB	Click here	Click here	Click here	Click here	Click here
TL384xB	Click here	Click here	Click here	Click here	Click here

8.2 Trademarks

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

8.3 静電気放電に関する注意事項

この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

8.4 用語集

テキサス・インスツルメンツ用語集　　この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

9 Revision History

Changes from Revision B (July, 2007) to Revision C (October, 2024) **Page**

- ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新 1
- Changed ESD ratings, CDM rating from ±3000V to ±2000V 4
- Changed thermal information for D-8, D-14, and P-8 packages 5
- Changed Electrical Char. table, TOTAL STANDBY CURRENT, VCC Zener voltage, typical value from 34V to 39V 5

- Changed in Electrical Char. table, Oscillator Section: at Tj=25C, min. value from 49kHz to 47kHz, max. value from 55kHz to 57kHz.....5
- Changed in Electrical Char. table, Oscillator Section: at TA=Tlow to Thigh, min. value from 48kHz to 44kHz, max. value from 56kHz to 60kHz.....5
- Changed in Electrical Char. table, OUTPUT Section: Rise and fall time, typical value from 50ns to 25ns..... 7
- Changed in Electrical Char. table, PWM: maximum duty cycle of TLx842/3B, minimum value from 94% to 92%.....7
- Changed in Electrical Char. table, PWM: maximum duty cycle of TLx844/5B, minimum value from 47% to 46%.....7
- Changed Part numbers edited.....7
- Updated the *Typical Characteristics* graphs for $I_{discharge}$ and Ta, I_{VCC}-V_{cc}, and D_{max} and Rt.....8
- Updated Application Curves for tdeadtime-Ct and Rt-f..... 17

10 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、テキサス・インスツルメンツの販売条件、または ti.com やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TL2842BD	Obsolete	Production	SOIC (D) | 14	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	TL2842B
TL2842BD-8	Obsolete	Production	SOIC (D) | 8	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	2842B
TL2842BDR	Active	Production	SOIC (D) | 14	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	TL2842B
TL2842BDR-8	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	2842B
TL2842BDR-8.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	2842B
TL2842BDR.A	Active	Production	SOIC (D) | 14	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	TL2842B
TL2842BP	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-40 to 85	TL2842BP
TL2842BP.A	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-40 to 85	TL2842BP
TL2843BD	Obsolete	Production	SOIC (D) | 14	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	TL2843B
TL2843BD-8	Obsolete	Production	SOIC (D) | 8	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	2843B
TL2843BDR	Active	Production	SOIC (D) | 14	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	TL2843B
TL2843BDR-8	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	2843B
TL2843BDR-8.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	2843B
TL2843BDR.A	Active	Production	SOIC (D) | 14	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	TL2843B
TL2843BDRG4-8	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	2843B
TL2843BP	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-40 to 85	TL2843BP
TL2843BP.A	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-40 to 85	TL2843BP
TL2844BD-8	Obsolete	Production	SOIC (D) | 8	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	2844B
TL2844BDR	Active	Production	SOIC (D) | 14	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	TL2844B
TL2844BDR-8	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	2844B
TL2844BDR-8.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	2844B
TL2844BDR.A	Active	Production	SOIC (D) | 14	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	TL2844B
TL2844BDRG4-8	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	2844B
TL2845BD	Obsolete	Production	SOIC (D) | 14	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	TL2845B
TL2845BD-8	Obsolete	Production	SOIC (D) | 8	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	2845B
TL2845BDR	Active	Production	SOIC (D) | 14	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	TL2845B
TL2845BDR-8	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	2845B
TL2845BDR-8.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	2845B
TL2845BDR.A	Active	Production	SOIC (D) | 14	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	TL2845B

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TL2845BDRG4-8	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	2845B
TL3842BD	Obsolete	Production	SOIC (D) | 14	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	TL3842B
TL3842BD-8	Obsolete	Production	SOIC (D) | 8	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	3842B
TL3842BDR	Active	Production	SOIC (D) | 14	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	TL3842B
TL3842BDR-8	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	3842B
TL3842BDR-8.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	3842B
TL3842BDR.A	Active	Production	SOIC (D) | 14	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	TL3842B
TL3842BP	Obsolete	Production	PDIP (P) | 8	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	TL3842BP
TL3843BD	Obsolete	Production	SOIC (D) | 14	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	TL3843B
TL3843BD-8	Obsolete	Production	SOIC (D) | 8	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	3843B
TL3843BDR	Active	Production	SOIC (D) | 14	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	TL3843B
TL3843BDR-8	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	3843B
TL3843BDR-8.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	3843B
TL3843BDR.A	Active	Production	SOIC (D) | 14	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	TL3843B
TL3843BP	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	TL3843BP
TL3843BP.A	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	TL3843BP
TL3844BD-8	Obsolete	Production	SOIC (D) | 8	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	3844B
TL3844BDR	Active	Production	SOIC (D) | 14	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	TL3844B
TL3844BDR-8	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	3844B
TL3844BDR-8.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	3844B
TL3844BDR.A	Active	Production	SOIC (D) | 14	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	TL3844B
TL3844BP	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	TL3844BP
TL3844BP.A	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	TL3844BP
TL3845BD	Obsolete	Production	SOIC (D) | 14	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	TL3845B
TL3845BD-8	Obsolete	Production	SOIC (D) | 8	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	3845B
TL3845BDR	Obsolete	Production	SOIC (D) | 14	-	-	Call TI	Call TI	0 to 70	TL3845B
TL3845BDR-8	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	3845B
TL3845BDR-8.A	Active	Production	SOIC (D) | 8	2500 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	0 to 70	3845B
TL3845BP	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	TL3845BP
TL3845BP.A	Active	Production	PDIP (P) | 8	50 | TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	0 to 70	TL3845BP

(1) **Status:** For more details on status, see our product life cycle.

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the TI RoHS Statement for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TL2843B :

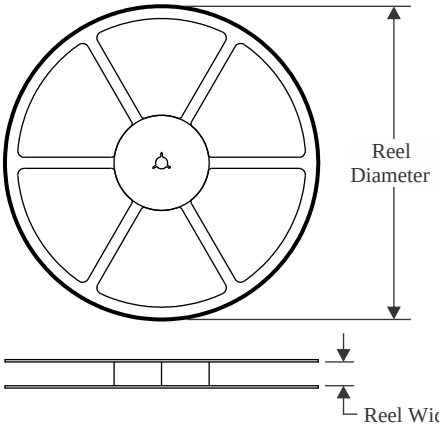
- Automotive : TL2843B-Q1

NOTE: Qualified Version Definitions:

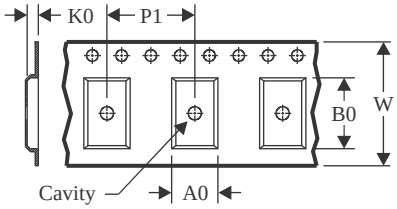
- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

TAPE AND REEL INFORMATION

REEL DIMENSIONS

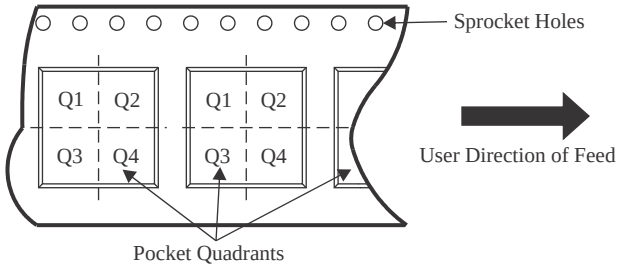


TAPE DIMENSIONS



A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

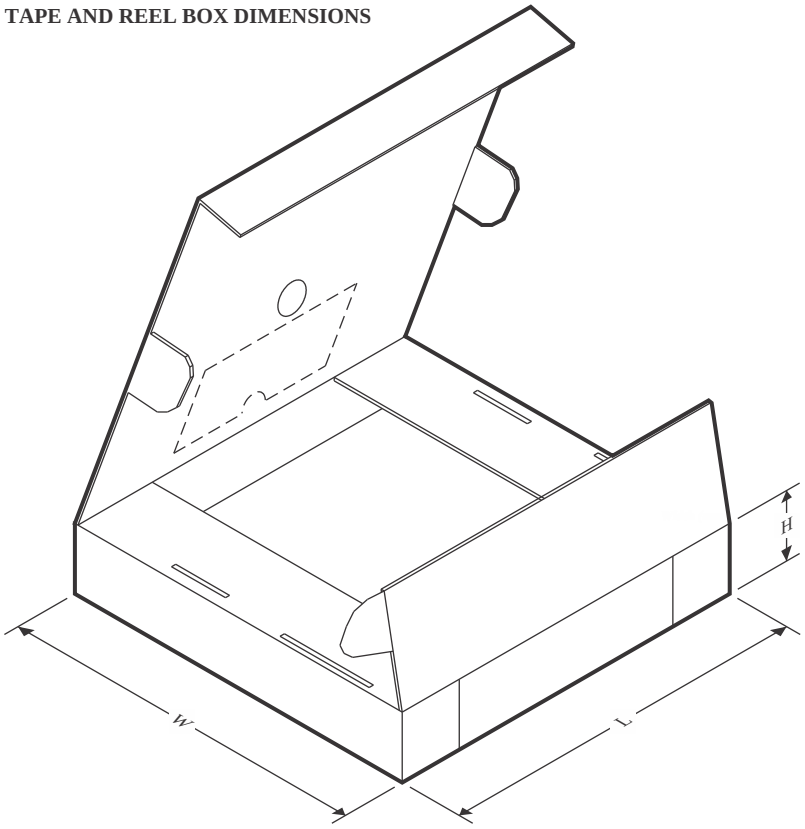
QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TL2842BDR	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
TL2842BDR-8	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
TL2843BDR	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
TL2843BDR-8	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
TL2844BDR	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
TL2844BDR-8	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
TL2845BDR	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
TL2845BDR-8	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
TL3842BDR	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
TL3842BDR-8	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
TL3843BDR	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
TL3843BDR-8	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
TL3844BDR	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
TL3844BDR-8	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1
TL3845BDR-8	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1

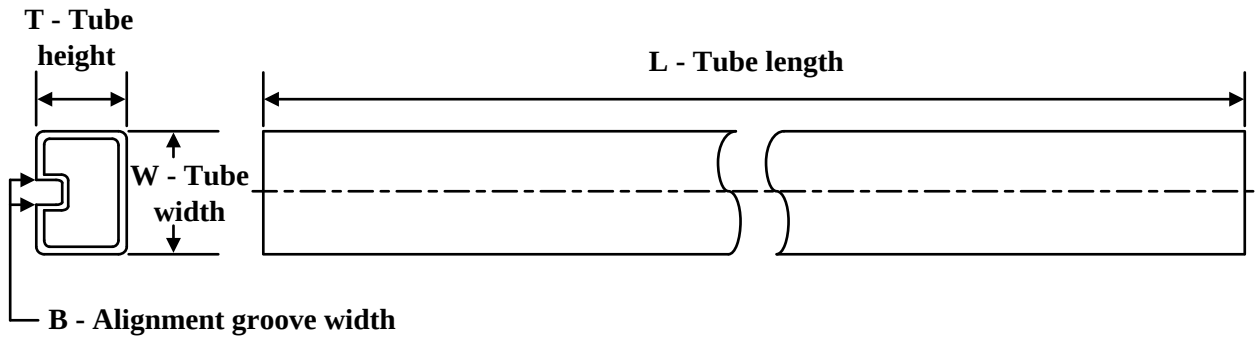
TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

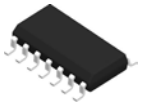
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TL2842BDR	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0
TL2842BDR-8	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
TL2843BDR	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0
TL2843BDR-8	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
TL2844BDR	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0
TL2844BDR-8	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
TL2845BDR	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0
TL2845BDR-8	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
TL3842BDR	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0
TL3842BDR-8	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
TL3843BDR	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0
TL3843BDR-8	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
TL3844BDR	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0
TL3844BDR-8	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0
TL3845BDR-8	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0

TUBE



*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (µm)	B (mm)
TL2842BP	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
TL2842BP.A	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
TL2843BP	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
TL2843BP.A	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
TL3843BP	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
TL3843BP.A	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
TL3844BP	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
TL3844BP.A	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
TL3845BP	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
TL3845BP.A	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32

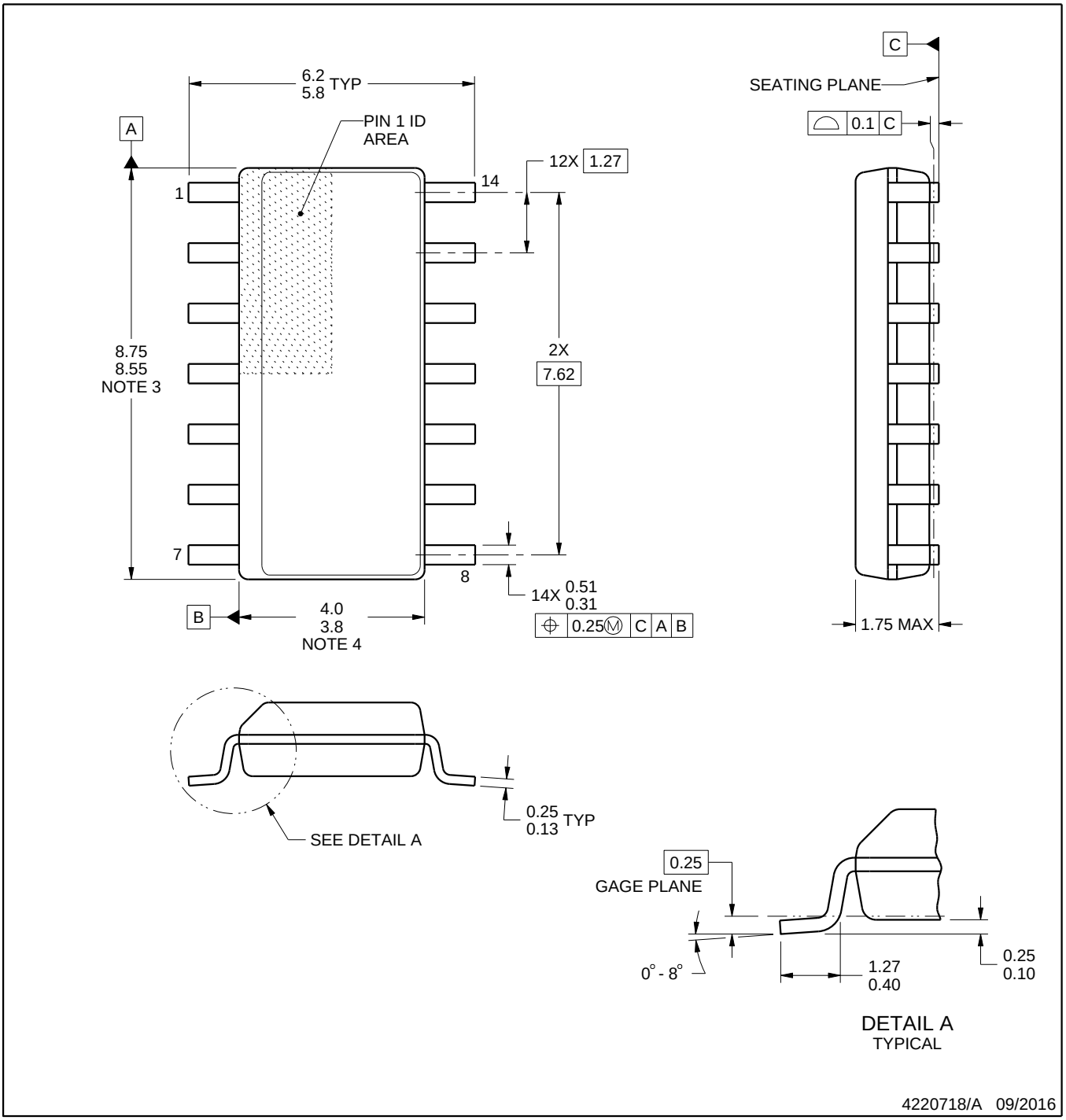


PACKAGE OUTLINE

D0014A

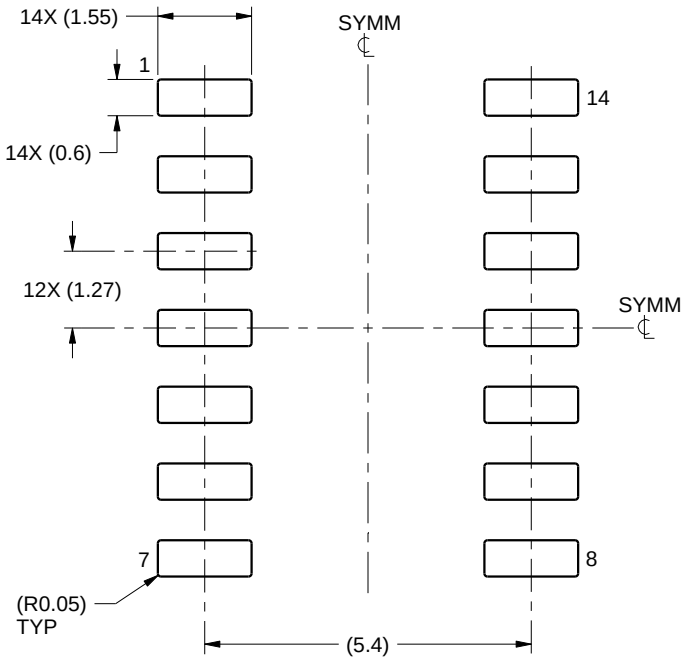
SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT

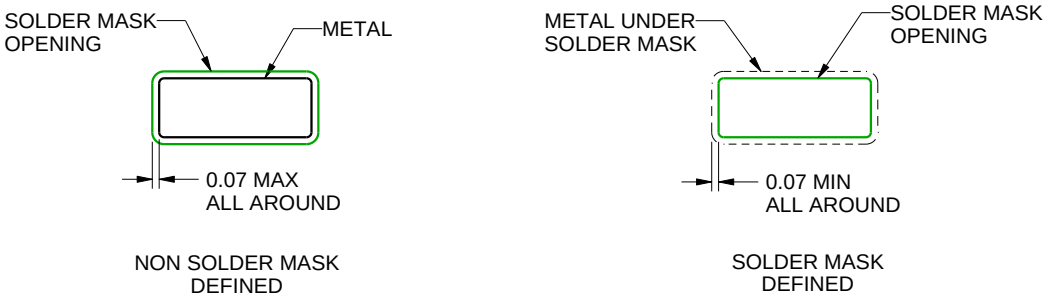


NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm, per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm, per side.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AB.



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:8X



SOLDER MASK DETAILS

4220718/A 09/2016

NOTES: (continued)

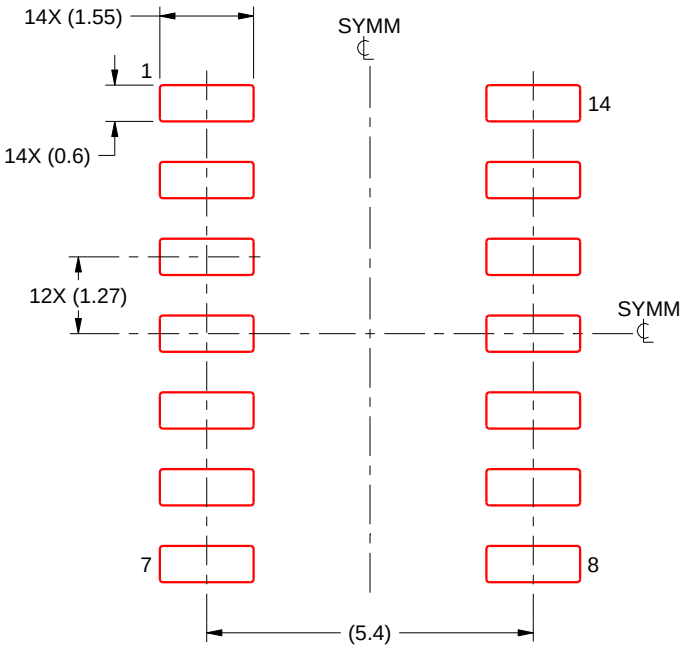
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

D0014A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT

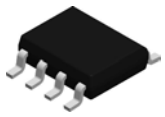


SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:8X

4220718/A 09/2016

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

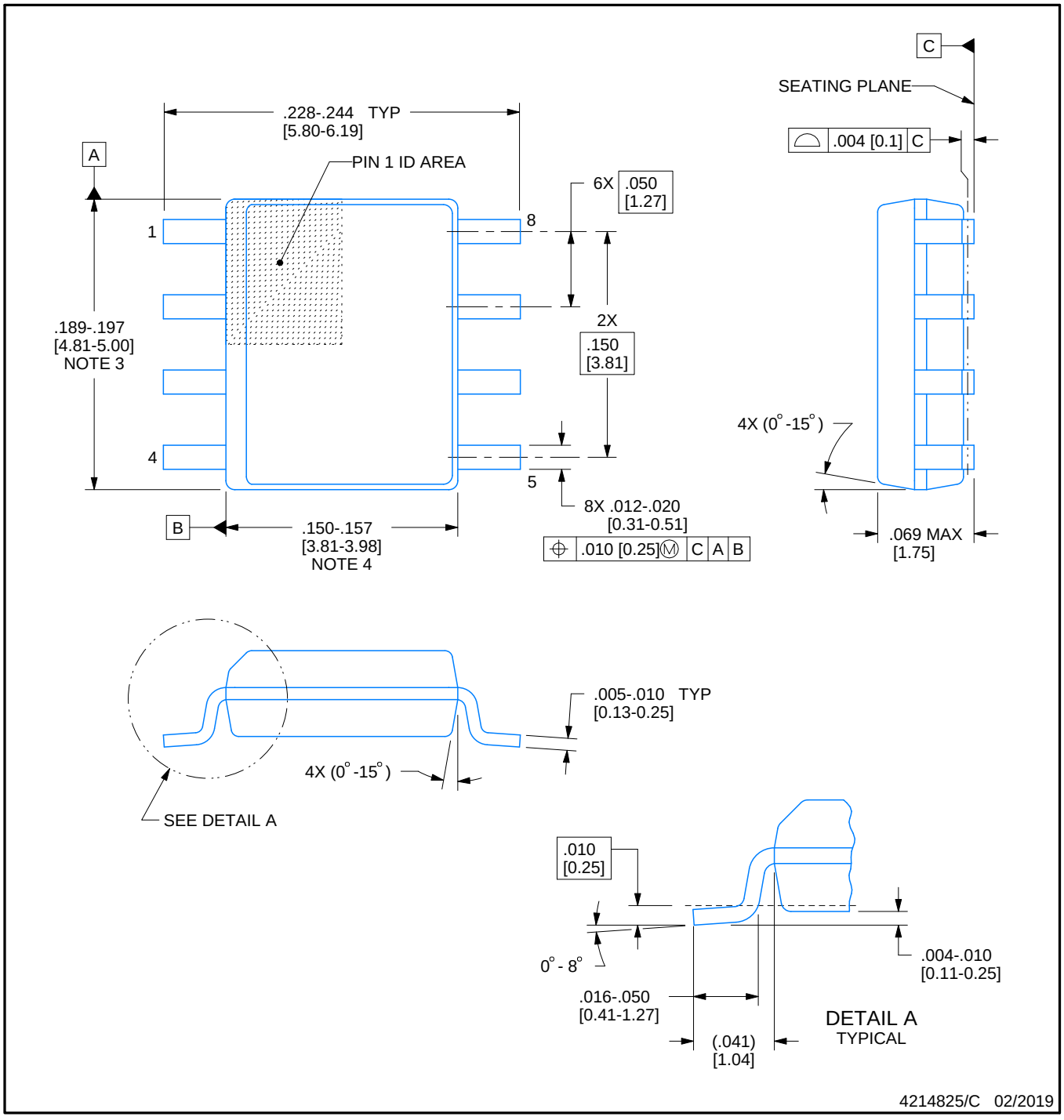


PACKAGE OUTLINE

D0008A

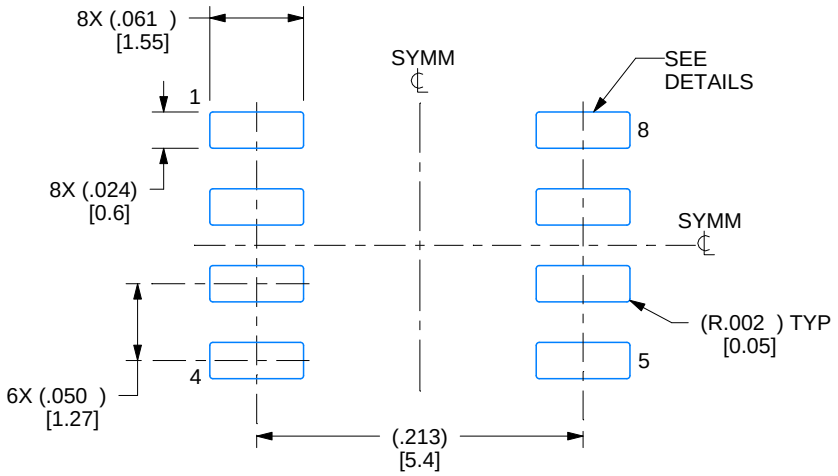
SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT

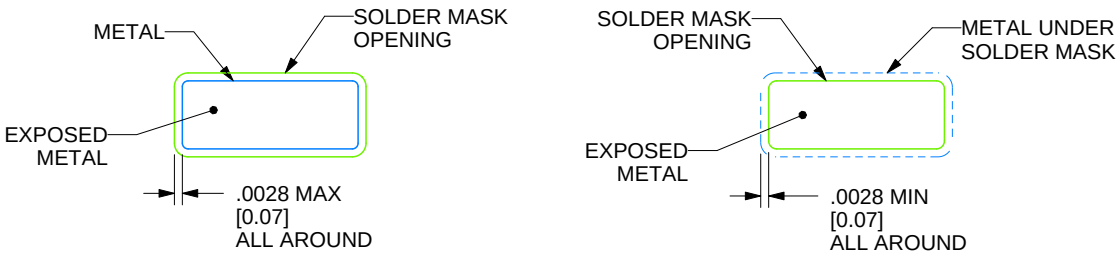


NOTES:

1. Linear dimensions are in inches [millimeters]. Dimensions in parenthesis are for reference only. Controlling dimensions are in inches. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed .006 [0.15] per side.
4. This dimension does not include interlead flash.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AA.



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:8X



SOLDER MASK DETAILS

4214825/C 02/2019

NOTES: (continued)

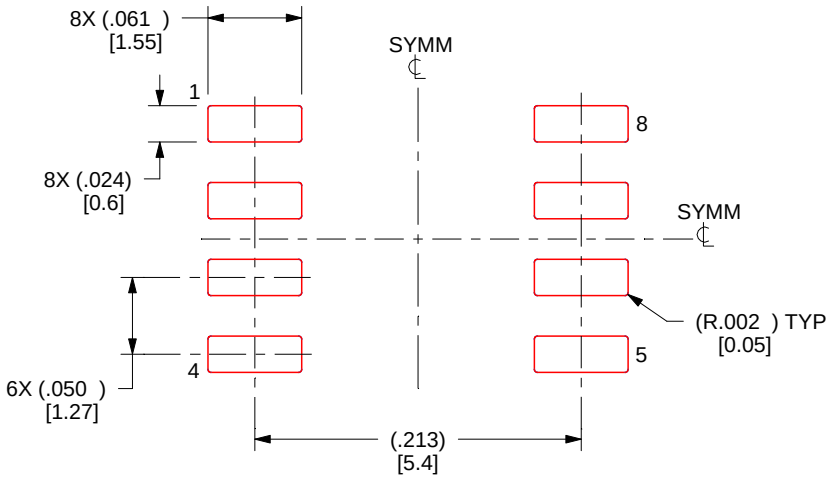
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

D0008A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



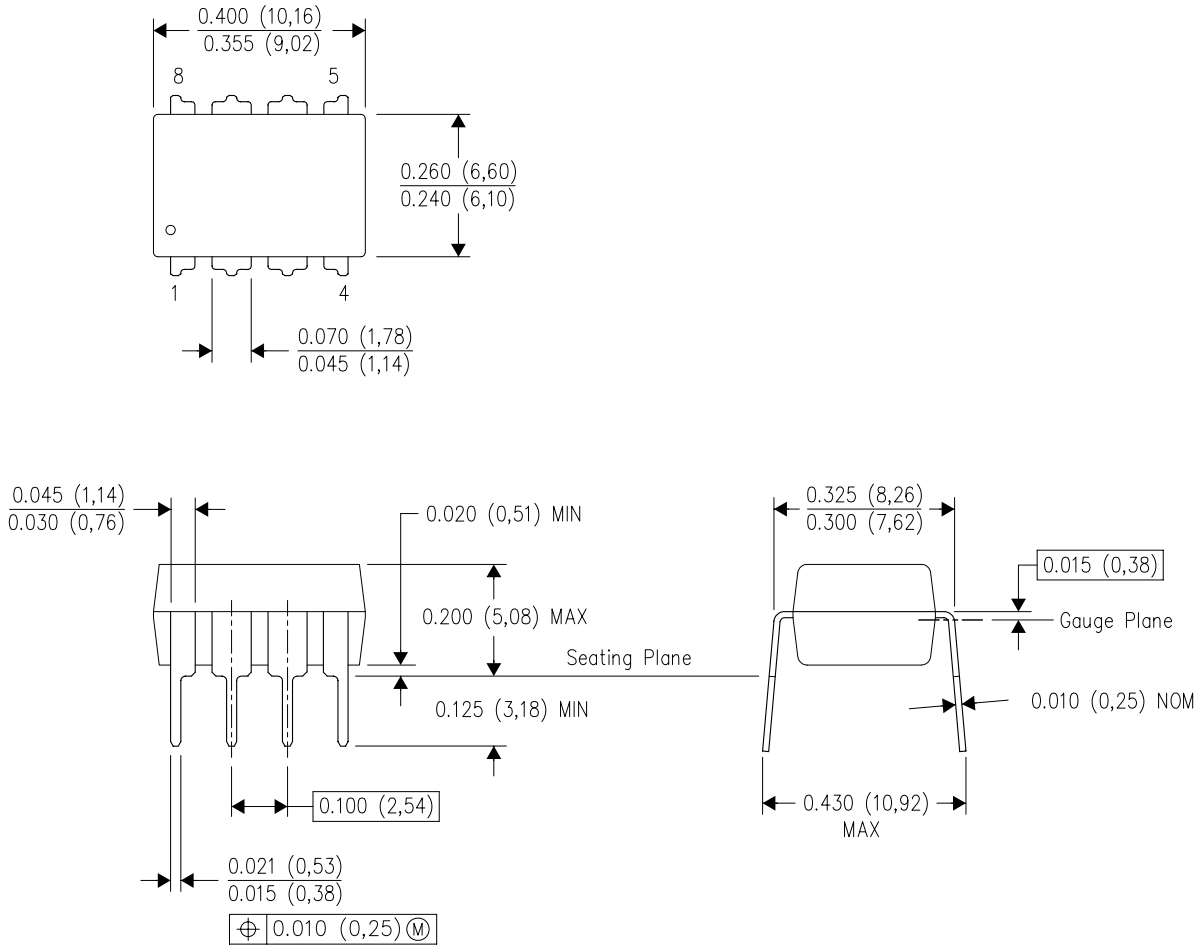
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON .005 INCH [0.125 MM] THICK STENCIL
SCALE:8X

4214825/C 02/2019

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

P (R–PDIP–T8) PLASTIC DUAL–IN–LINE PACKAGE



NOTES:
A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Falls within JEDEC MS–001 variation BA.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、 TI の販売条件 、 TI の総合的な品質ガイドライン 、 ti.com または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。 TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

最終更新日：2025 年 10 月